

# 박진성

박진성은 서울캠퍼스 [공과대학 신소재공학부](#) 교수이자 [정보소재 및 전자소자 연구실](#)장을 겸하고 있다.

- 연락처: 02-2220-0401 / jsparklime@hanyang.ac.kr
- 홈페이지: <http://hylime.kr/default/>

□

## 목차

- [1 학력](#)
- [2 경력](#)
- [3 수상](#)
- [4 학회활동](#)
- [5 연구관심분야](#)
- [6 담당과목](#)

## 학력

- 1999.03 ~ 2002.08 한국과학기술원, 재료공학과, 공학박사
- 1997.03 ~ 1999.02 한국과학기술원, 재료공학과, 공학석사
- 1993.03 ~ 1997.02 한국과학기술원, 재료공학과 공학사

## 경력

- 2013.03 ~ 현재 한양대학교 신소재공학부, 부교수
- 2009.09 ~ 2013.02 단국대학교 신소재공학과, 조교수
- 2008.09 ~ 2009.08 삼성 모바일 디스플레이, 기술센터, 책임연구원
- 2005.03 ~ 2008.08 삼성 SDI, 중앙연구소, 책임연구원
- 2003.01 ~ 2005.01 Havard 대학교, 화학과, 박사후연구원
- 2002.09 ~ 2002.12 한국과학기술원, 신소재공학과, 박사후연구원

## 수상

- 2021, 머크 스페셜 어워드 수상
- 2020, 제 20회 국제정보디스플레이 학술대회 Most Cited Paper 어워드 수상
- 2014, 제11회 머크 젊은 과학자상 수상

# 학회활동

- 2013.01 ~ 현재 한국재료학회, 평의원
- 2012.03 ~ 현재 충남미래기술기획위원회 전문위원
- 2012.01 ~ 현재 한국정보디스플레이학회, 기획이사
- 2010.01 ~ 현재 한국정보디스플레이학회, 평의원
- 2010.01 ~ 2011.12 한국정보디스플레이학회, 협동이사
- 2009.11 ~ 2010.10 삼성종합기술원, 자문교수

# 연구관심분야

- 차세대 정보 전자 소재와 소자 개발 및 응용(투명 산화물 반도체 재료 및 소자, 투명 배선 재료 개발 및 응용, 유연 전자 소자향 보호막 재료 및 공정 개발, IT/BT/NT용 기능성 박막 재료/공정 개발)
- 원자층 증착법을 통해 3차원 집적 공정이 가능한 초고이동도 유사 단결정 산화물 반도체 소재 개발<sup>[1]</sup>
  1. 플라즈마 원자층 증착법 (PEALD)을 활용하여 ‘유사 단결정 구조의 IGZO 산화물 반도체 물질’을 단결정 성장 온도 (>1000oC) 대비 매우 낮은 온도 (200oC) 에서 성장시켰다. 이를 통해 제작된 산화물반도체(IGZO) 트랜지스터 소자는 세계 최고 수준의 전계 이동도 (> 100 cm<sup>2</sup>/Vs)를 가지면서도 열과 외부 전계에 대한 높은 소자 안정성을 보여주었다. 소비전력을 대폭 낮추면서도 초고해상도 구현이 가능한 것이다. 또한, 기존 물리적 증착법의 한계를 넘어 3차원 구조에서 90% 이상의 두께 및 조성 균일도를 확보하였다.
  2. 이번 연구는 산업통상자원부 산업기술혁신사업 및 삼성디스플레이의 지원을 받아 진행되었으며, 연구결과는 소재분야 세계적인 학술지인 「Small methods, (IF = 15.367)」 에 6월 발표되었다.
  3. 해당 논문은 한양대 신소재공학과 김윤서 연구자 (박사과정)이 제 1저자, 삼성디스플레이 임준형 마스터가 공동교신저자로 참여했다.
- 초고이동도 유사 단결정 산화물 반도체(이하 IGZO) 소재 개발<sup>[2]</sup>
  1. 박진성 신소재공학부 교수가 이끄는 연구팀인 정보소재 및 전자소자 연구실이 초고이동도 유사 단결정 산화물 반도체(이하 IGZO) 소재 개발에 성공했다. 박 교수 연구팀의 김윤서(신소재공학부 석박사통합과정) 씨는 해당 연구의 제1 저자로 참여했다.

# 담당과목

- 학부: 전자소자재료
- 대학원: 디스플레이공학

1. [↑](#) <뉴스H> 2023.07.12 [한양대, 초고이동도 IGZO 반도체 소재 개발](#)
2. [↑](#) <뉴스H> 2023.07.27 [박진성 교수 · 김윤서 학생, 초고이동도 IGZO 반도체 소재 개발로 지평을 넓혀](#)